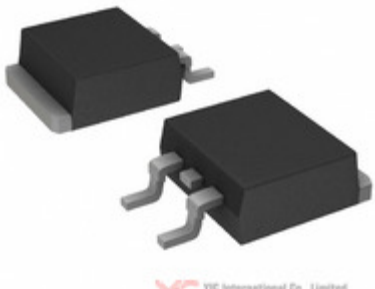
	<p><b>FESB8AT-E3/81</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FESB8AT-E3/81</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 50V 8A TO263AB</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FESB8AT-E3/81.pdf</a> <a href="#">2.FESB8AT-E3/81.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen









Teilenummer	FESB8AT-E3/81
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 50V 8A TO263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	950mV @ 8A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	50V
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	35ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 50V
Strom - Richt (Io)	8A
Kapazität @ Vr, F	-

FESB8AT-E3/81 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FESB8AT-E3/81-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FESB8AT-E3/81 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FESB8AT-E3/81 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>FESB8BT</b> VISHAY FESB8BT VISHAY</p>	 <p><b>FESB8BT-E3</b> VISHAY FESB8BT-E3 VISHAY</p>	 <p><b>FESB16JT-E3/81</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 16A TO263AB</p>	 <p><b>FESB8AT-E3/81</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 50V 8A TO263AB</p>
 <p><b>FESB8ATHE3/81</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 50V 8A TO263AB</p>	 <p><b>FESB16JT-E3/81</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 16A TO263AB</p>	 <p><b>FESB16JT-E3/81</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 16A TO263AB</p>	 <p><b>FESB8ATHE3/81</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 50V 8A TO263AB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FESB8AT-E3/81 Vishay / Semiconductor - Diodes Division	FESB8AT-E3/81 Datenblatt	FESB8AT-E3/81-Datenblätter	FESB8AT-E3/81 PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division FESB8AT-E3/81
FESB8AT-E3/81 Electronic	FESB8AT-E3/81-Komponenten	FESB8AT-E3/81-Verteiler	FESB8AT-E3/81-Bild	FESB8AT-E3/81-Teil
FESB8AT-E3/81 Preis	FESB8AT-E3/81 Hersteller	FESB8AT-E3/81 Bild	FESB8AT-E3/81 Aktie	FESB8AT-E3/81 Inventar
FESB8AT-E3/81 Neu	FESB8AT-E3/81 Original	FESB8AT-E3/81 garantiert	FESB8AT-E3/81 RFQ	FESB8AT-E3/81 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited